

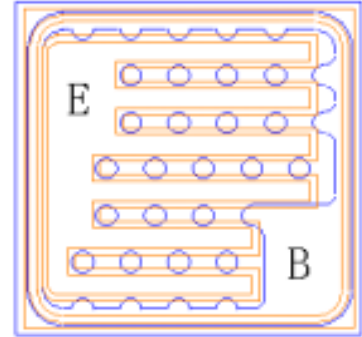


D880 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
 芯片代码：C150AG-01
 芯片厚度：240 ± 20μm
 管芯尺寸：1500 × 1500μm²
 焊位尺寸：B 极 290×450μm²；E 极 285×450μm²
 电极金属：铝
 背面金属：银
 典型封装：2SD880，HD880

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-220)

T_{stg}——贮存温度..... -55~150
 T_j——结温.....150
 P_C——集电极耗散功率.....30W
 V_{CB0}——集电极—基极电压..... 60V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压..... 60V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....7V
 I_C——集电极电流..... 3A
 I_B——基极电流..... 0.3A

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-220)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			100	μA	V _{CB} =60V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			100	μA	V _{EB} =7V, I _C =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	60				I _C =50mA, I _B =0
h _{FE}	直流电流增益	60		300		V _{CE} =5V, I _C =0.5A
	直流电流增益	20				V _{CE} =5V, I _C =3A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压		0.4	1	V	I _C =3A, I _B =0.3A
V _{BE(on)}	基极—发射极导通电压		0.7	1	V	V _{CE} =5V, I _C =0.5A
f _T	特征频率		3		MHz	V _{CE} =5V, I _C =0.5A
C _{ob}	共基极输出电容		70		pF	V _{CB} =10V, I _E =0, f=1.0 MHz
t _{ON}	导通时间		0.8		μs	V _{CE} =30V, I _C =2A I _{B1} =-I _{B2} =0.2A
t _{STG}	载流子贮存时间		1.5		μs	
t _F	下降时间		0.8		μs	